		Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
2021.00	Еро. примен.	B1	Преобразователь Button 2 Conn SMD	1	
B		51.50	KOHDEHCOMOPI BOAS BOAS		BOAS
		(1, (2	0.1uF X7R 16V 10% 0603	2	
f		<i>C3, C4</i>	18pF NPO 50V 5% 0805	2	
		<i>C</i> 5	4.7uF X5R 25V 10% 0603	1	
		C6-C11	0.1uF X7R 16V 10% 0603	6	
0/ V	прав. №	,	4.7uF X5R 25V 10% 0603	2	
_		<i>C14–C17</i>	0.1uF X7R 25V 10% 0805	4	
Bl	A	} *	Tem Cogn S BOAS BOAS	1	BUAS
			Конденсаторы		
L		C 18	0.1uF X7R 25V 10% 0805	1	
		£ 10 £ 19	ECAP SMD,	1	
		217	35V, 105°C	,	
Γ.		<i>C20-C23</i>	150pF NPO 5% 50V 0805	4	
900	חמוומ	C24	4.7uF X5R 25V 10% 0603	1	
		5	BOAS BOAS BOAS		BOAS
2	101				
200		СЬ1	10nF X7R 10% 50V 1206	1	
28.15 01V 8.18	hn v	Cin1, Cin2	4.7uF X7R 10% 50V 1206	2	
8,1	1. UHI	Cin3	10nF X7R 10% 50V 1206	1	
0/ V	>	Co1	ECAP SMD,	1	
8, "	UHD.		16V, 105°C, 20%		
R	Ded V	<u> </u>	TECAP, 10uF, 16V, case A, 10% AS	1	BOAS
	4 / /	СаЗ	10nF X7R 10% 50V 1206	1	20710
9	מוומ				
ָ ֖֖֖֖֖֖֖֖֖֖֓֞֞֞֞	וטטוו. ע טעוווע				
100	10011		Перечень элементов		
-	_	Изм. /lucm № докум. Подп. Дата			
, CO) 1001	Пров.			1 1 4
B		Н,контр.	ВОАЅ ВОА Перечень элементов АЅ		BOAS
	`	Утв.	Копировал		Формат А4

	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
	D1	Схемы интегральные High peak pulse power: 200 W (10/1000 µs)	1	
RNA	D2, D3	The SM24EANB TVS Diode Array is designed to protect automotive.	2	RNAS
DOTT),	Controller Area Network (CAN) lines from damage due to electrostatic		DONO
		discharge (ESD), electrical fast transient (EFT), and other overvoltage		
		transients.		
	D4, D5	0.5 A, Low Forward Voltage less than 385 mV, 400 mW Power Dissipation	2	
		Package		
RNA		RNAS RNAS RNAS		RNAS
DOM	Din1	600W	1	DONO
	Do1	Diode Schottky 5A 40V	1	
	Do2	ESD Suppressor TVS 30KV,130W,	1	
		SOD-323		
	J1	Stac64 Right-Angle Header Assembly, 8 Circuits, Polarization A, Black, Tray	1	
ата	J2	CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDER	1	
	J3 ''	Header, 6-Pin	1	RNAS
<u>Nodn.</u>) J4 J5	USB Type C 2.0 16 pin	1	DONO
	Lo1	15uH, 1.53A, 7X7	1	
Инв. № дцъл.	LUT	ווטנון, וו.טבא, ואון	/	
B. No		Резисторы		
No MH	R1	0.1W 0603 62R, 1%	1	
инв. Л	R2	0.125W 0805 3.9k, 1%	1	
Bag A S	R3-R5	0.1W PGOB 62R, 1% RAS	3	RNAS
	R6, R7	0.1W 0603 4.7k, 1%	2	DUAD
משונ				
Подп. и дата				
Подг	Rfb1	0.1W 0603 62R, 1%	1	
) М° подл.				
\mathbb{R}^{6}	Изм. Лист	ROAS BOAS Перечень эдех	1ентов	$\frac{1}{2}$ BOAS $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Копировал

Формат А4

Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
Rfb2	0.1W 0603 3k, 1% BOAS BOAS BOAS	1	BOAS
SB1, SB2	Выключатель кнопочный Circuit Breaker	2	
T1, T2	Трансформатор Common mode filters	2	
	train/safety)		
BOAS U1	Модуляторы A family of EMOS low dropout (LDO) voltage regulators	1	BOAS
	that can deliver		
	ир to		
Bodin Walama	to 250 mA ofcurrent S BOAS BOAS		BOAS
ΩΩ.	while consuming		
Инв. N° дубл	only 1.6 μA		
UHB. No	of quiescentcurrent (typical). The input operating range is specifiedfrom 2.3V to		
BEAS U2	6. DAS BOAS BOAS MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP	1	BOAS
Подп. и дата			
17. A	ВОДЅ Перечень элек № докум. Подп. Дата	1ент	rob BOAS //ucm

Копировал

Формат А4

	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
BOAS	<i>U3, U4</i>	Модуляторы High-speed CAN DAS BOAS fault-tolerantdevice that	2	BOAS
		serves as the interface		
BOA:	U5	between AS BOAS a CANprotocol controller and the physical bus. RS-232 Dual Transmitters/Receivers, Maxim Integrated	1	BOAS
ата	Udc1	The TPS5450 is a high-output-current PWM converter that integrates a low-resistance, high-side N-channel MOSFET	1	
57. Nodo. w da	Y1	BOAS BOAS BOAS Устройство механическое с электромагнитным приводом Crystal. HC- 49SM (US)	1	BOAS
инв. N° Инв. N° дубл				
Todn. u dama B3aiv.		BOAS BOAS BOAS		BOAS
	Изм. Лист	BOAS BOAS Перечень ⊅лек	1 <i>e</i> HM	nob BOAS Aucm

Копировал

Формат А4